

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年4月12日 (2012.4.12)

【公開番号】特開2010-251632(P2010-251632A)

【公開日】平成22年11月4日 (2010.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-044

【出願番号】特願2009-101679(P2009-101679)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/78 (2006.01)

H 0 1 L 29/739 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

H 0 1 L 21/318 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 29/78 6 5 8 G

H 0 1 L 29/78 6 5 5 B

H 0 1 L 29/78 6 5 8 F

H 0 1 L 29/78 6 5 8 Z

H 0 1 L 29/78 6 5 8 A

H 0 1 L 29/78 6 5 5 C

H 0 1 L 29/78 6 5 2 L

H 0 1 L 29/78 6 5 2 M

H 0 1 L 29/78 6 5 8 L

H 0 1 L 29/78 6 5 5 F

H 0 1 L 21/66 B

H 0 1 L 21/318 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月29日 (2012.2.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の工程を含む半導体装置の製造方法：

- ( a ) 第1の厚さを有する半導体ウエハの第1の主面上に、第1の金属膜を形成する工程；
- ( b ) 前記工程 ( a ) の後、前記半導体ウエハの第 2 の主面側に対して、バック・グラインディング処理を実行することにより、前記第1の厚さよりも薄い第2の厚さとする工程；
- ( c ) 前記工程 ( b ) の後、前記半導体ウエハの前記第 2 の主面上に、その周辺に沿って、第1の絶縁膜からなり、前記第 2 の主面の周辺に沿う円環状絶縁膜パターンを含む絶縁膜パターンを形成する工程；
- ( d ) 前記絶縁膜パターンがある状態で、前記円環状絶縁膜パターンの開口部の厚さを前記第 2 の厚さよりも薄い第 3 の厚さとする工程；
- ( e ) 前記工程 ( d ) の後、前記絶縁膜パターンがある状態で、前記半導体ウエハに対して、電氣的テストを実行する工程；
- ( f ) 前記工程 ( e ) の後、前記絶縁膜パターンがある状態で、前記半導体ウエハの前記第 2 の主面を粘着シートに貼り付けることにより、前記粘着シートを介してダイシング・

フレームに保持させる工程；

( g ) 前記工程 ( f ) の後、ダイシング・フレームに保持された状態で、前記半導体ウエハを個々のチップに分割する工程。